

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI FINI DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI UN PROFILO DI “RICERCATORE/RICERCATRICE PER LA DEPOSIZIONE E
CARATTERIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CELLE FOTOVOLTAICHE A MULTI-GIUNZIONE (MJ)” (RIF 26.55)**

Ai sensi degli Artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto _____ C.F. _____ consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

- di aver maturato conoscenze ed esperienze e capacità relative ai temi del bando in oggetto, come meglio specificato nel seguito:
 - Competenze di chimica
 - Competenze sulla crescita MOCVD e sulla caratterizzazione dei materiali semiconduttori
 - Conoscenze di base sui dispositivi di materiale semiconduttore
 - Esperienze di attività sperimentali e/o di laboratorio nel campo della deposizione di materiali semiconduttori mediante tecniche chimico-fisiche
 - Ottima conoscenza della lingua italiana (almeno equivalente al livello C1)
 - Buona conoscenza della lingua inglese
 - Capacità di lavorare in gruppo
 - Competenze sull’utilizzo di software Microsoft (Word, Excel)
 - Capacità di *problem solving*
 - Capacità di apprendimento continuo
 - Predisposizione alle attività di ricerca.

- Di aver conseguito una o più lauree magistrali nelle seguenti classi:
 - Laura magistrale in Fisica LM-17-R
 - Laura magistrale in Ingegneria Chimica LM-22
 - Laura magistrale in Ingegneria dei Materiali LM-53
 - Laura magistrale in Scienze Chimiche LM-54_R
 - Laura magistrale in Scienze dei Materiali LM-SC.MAT

- Che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae, trasmesso con la candidatura alla procedura di selezione per il profilo di “Ricercatore/Ricercatrice per la deposizione e caratterizzazione di strutture di celle fotovoltaiche a multi-giunzione (MJ)” (rif 26.55), corrisponde al vero.

Luogo e data

Firma
